

А. В. КОЛПАКОВ

ДИФРАКЦИОННОЕ ОТРАЖЕНИЕ И ПРОХОЖДЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ В ИДЕАЛЬНЫХ КРИСТАЛЛАХ

При рассмотрении дифракции рентгеновских лучей в идеальных кристаллах вводится нелокальная связь между векторами электрической индукции и напряженностью поля $\vec{D}(\vec{k}_i) = \int \varepsilon'(\vec{k}_i - \vec{k}_j) \vec{E}(\vec{k}_j) dv$. Это позволяет свести задачу к распространению связанных дифракционных волн. В качестве примера проводится решение двухлучевых задач отражения и прохождения. В качестве метода решения используется метод укороченных уравнений.

Проблема дифракции рентгеновских лучей в идеальных или почти идеальных кристаллах может быть сведена к задаче о распространении связанных дифракционных волн в непрерывной дипольной среде [1]. При этом каждому дифракционному направлению следует приписать свою диэлектрическую проницаемость $\varepsilon(\vec{k})$. Тогда амплитуды рассеянных волн могут быть определены из некоторой системы волновых уравнений, решение которой может быть найдено методом укороченных уравнений [2—3].

Указанный подход будет продемонстрирован на примере решения классических двухлучевых задач дифракционного отражения и прохождения [4—7] рентгеновских лучей в идеальных непоглощающих кристаллах, с постоянными вдоль данного направления диэлектрическими проницаемостями.

Определение электрической индукции

Поле излучения в кристалле описывается уравнениями Максвелла:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{H} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, & \operatorname{div} \vec{D} &= 4\pi\rho, \\ \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}, & \operatorname{div} \vec{H} &= 0. \end{aligned} \quad (1)$$

Полагая, что поле в кристалле чисто поперечное из (1) получим

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial t^2} = 0. \quad (2)$$

Для монохроматических по времени полей волновое уравнение (2) принимает вид

$$\nabla^2 \vec{E}(\vec{r}) + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \vec{D}(\vec{r}) = 0. \quad (3)$$

Согласно [1], будем рассматривать кристалл как среду с нелокальным взаимодействием. Тогда индукция \vec{D} и напряженность \vec{E} оказываются связанными интегральным соотношением

$$\vec{D}(\vec{k}_i) = \int \varepsilon'(\vec{k}_i - \vec{k}_j) \vec{E}(\vec{k}_j) = dV, \quad (4)$$

где \vec{k}_i — волновой вектор i -того дифракционного пучка, так что волновое уравнение (3) становится интегро-дифференциальным. Поскольку условия дифракции накладывают весьма строгие ограничения на возможные направления распространения волн в кристалле, можно считать, что $\varepsilon'(\vec{k}_i - \vec{k}_j)$ отлична от нуля только при $\vec{k}_i - \vec{k}_j = \vec{H}$, где \vec{H} — какой-либо вектор обратной решетки.

Следовательно, можно положить $\varepsilon'(\vec{k}_i - \vec{k}_j) = \varepsilon_{ij}(\vec{r}) \delta(\vec{k}_i - \vec{k}_j - \vec{H})$, тогда интегрирование в (4) выполняется непосредственно:

$$\vec{D}_i(\vec{r}) = \varepsilon_{ij}(\vec{r}) \vec{E}_j(\vec{r}) = (\delta_{ij} + 4\pi\chi_i(\vec{r})) \vec{E}_j(\vec{r}), \quad (5)$$

где δ_{ij} — символ Кронекера. Подставляя (5) в (3), приходим к системе волновых уравнений, описывающей взаимодействующие дифракционные пучки:

$$\nabla^2 \vec{E}_i(\vec{r}) + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \varepsilon_{ij}(\vec{r}) \vec{E}_j(\vec{r}) = 0. \quad (6)$$

Задача определения волнового поля в кристалле, таким образом, сводится к отысканию решения системы (6) при соответствующих граничных условиях.

Уравнения поля в двухволновом случае

Рассмотрим решение системы уравнений (6) на примере двухлучевой дифракции плоской волны, падающей под углом $\psi = \varphi + \theta_0$ на бесконечно протяженную плоско-параллельную пластину толщиной z_0 . Вектор обратной решетки, соответствующий дифрагированной волне, может составлять произвольный угол φ с нормалью к поверхности кристалла. При этом возможны два случая: 1) если $\varphi < \theta_0$, где θ_0 — неисправленный на преломление угол Брэгга, то падающая и дифрагированная волны лежат по одну сторону пластины (отражение) и 2) если $\varphi > \theta_0$, то падающая и дифрагированная волны лежат с разных сторон пластины (прохождение). Введем систему координат так, чтобы ось x шла вдоль поверхности кристалла, а ось z — перпендикулярно ей. Тогда система уравнений (6) примет вид

$$\frac{\partial^2 E_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_i}{\partial z^2} + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 E_i + 4\pi \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \chi_{ii} E_i + 4\pi \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \chi_{ij} E_j = 0, \quad (7)$$

где $ij=1, 2; i \neq j$.

Система уравнений (7) эквивалентна дифференциальным уравнениям четвертого порядка для напряженностей E_1 и E_2 , которые могут

быть решены точно в случае постоянных χ_{ij} . Если же χ_{ij} являются функциями координат, то даже при самых простых зависимостях при решении этих уравнений возникают непреодолимые трудности¹. Поэтому вместо прямого решения системы (7) мы воспользуемся методом [2, 3 и 8, 9], который может быть применен и в случае зависящих от координат величин χ_{ij} .

Решение системы волновых уравнений

Будем искать решение системы (7) в виде распространяющихся волн с переменными амплитудами. В выбранной нами системе координат имеем

$$\begin{aligned} E_1 &= E_1(x, z) e^{i \frac{\omega}{c} \cos(\varphi + \theta_0)x} e^{i \frac{\omega}{c} \sin(\varphi + \theta_0)z}, \\ E_2 &= E_2(x, z) e^{i \left(\frac{\omega}{c}\right)' \cos(\varphi - \theta_0)x} e^{i \left(\frac{\omega}{c}\right)' \sin(\varphi - \theta_0)z}, \end{aligned} \quad (8)$$

где $\left(\frac{\omega}{c}\right)' = \left(\frac{\omega}{c}\right) (1 + \alpha_H)$, а α_H — величина, пропорциональна необходимому для выполнения условий дифракции отклонению от неисправленного угла Брэгга θ_0 : $\alpha_H = -\Delta \sin 2\theta_0$. Будем считать, что излучение поляризовано полностью, причем вектор напряженности \vec{E} перпендикулярен плоскости падения. Подставляя (8) в (7) и учитывая малость взаимодействия с отдельной атомной плоскостью (в силу чего имеет место неравенство $\partial^2 E / \partial r^2 \ll k \partial E / \partial r$), вместо волновых уравнений (7) получим систему линейных дифференциальных уравнений с частными производными для амплитуд $E_i(x, z)$ и $E_2(x, z)$

$$\cos(\varphi + \theta_0) \frac{\partial E_1}{\partial x} + \sin(\varphi + \theta_0) \frac{\partial E_1}{\partial z} + a_{11} E_1 + a_{12} E_2 = 0, \quad (9')$$

$$\cos(\varphi - \theta_0) \frac{\partial E_2}{\partial x} + \sin(\varphi - \theta_0) \frac{\partial E_2}{\partial z} + a_{21} E_1 + a_{22} E_2 = 0, \quad (9'')$$

где $a_{ij} = i \frac{\omega}{c} (2\pi\chi_{ij} + \alpha_{ij})$ и имеют смысл коэффициентов отражения, а матрица $\| \alpha_{ij} \|$ имеет вид $\| \alpha_{ij} \| = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \alpha_H & 0 \end{bmatrix}$.

Исключая из (9') E_2 и подставляя в (9''), получим уравнение второго порядка для амплитуды E_1

$$\begin{aligned} &\cos(\varphi + \theta_0) \cos(\varphi - \theta_0) \frac{\partial^2 E_1}{\partial x^2} + \sin 2\varphi \frac{\partial^2 E_1}{\partial x \partial z} + \\ &+ \sin(\varphi + \theta_0) \sin(\varphi - \theta_0) \frac{\partial^2 E_1}{\partial z^2} + (a_{11} \cos(\varphi - \theta_0) + \\ &+ a_{22} \cos(\varphi + \theta_0)) \frac{\partial E_1}{\partial x} + (a_{11} \sin(\varphi - \theta_0) + a_{22} \sin(\varphi + \theta_0)) \times \\ &\times \frac{\partial E_1}{\partial z} + (a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}) E_1 = 0. \end{aligned} \quad (10)$$

¹ Величины χ_{ij} могут оказаться функциями координат по двум причинам: если атомные плоскости несколько смещены или деформированы, тогда χ_{ij} , оставаясь постоянными, приобретают зависящие от координат фазовые множители; в другом предельном случае атомные плоскости могут быть расположены в идеальном порядке, но их рассеивающие способности меняются от точки к точке, тогда и χ_{ij} становятся зависящими от координат.

Общее решение уравнения (10) имеет вид

$$E_1(x, z) = (c_1' e^{\lambda_1 z} + c_2' e^{\lambda_2 z}) (c_1'' e^{\mu_1 x + \nu_1 z} + c_2'' e^{\mu_2 x + \nu_2 z}), \quad (11)$$

где

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{\sin 2\theta_0} (a_{11} \cos(\varphi - \theta_0) - a_{22} \cos(\varphi + \theta_0)) \pm$$

$$\pm \sqrt{\frac{a_{12} a_{21} + m}{\sin(\varphi - \theta_0) \sin(\varphi + \theta_0)}},$$

$$\mu_{1,2} = \frac{1}{\sin 2\theta_0} (a_{11} \sin(\varphi - \theta_0) - a_{22} \sin(\varphi + \theta_0)) \pm$$

$$\pm 2\sqrt{m \sin(\varphi - \theta_0) \sin(\varphi + \theta_0)},$$

$$\nu_{1,2} = \pm \frac{\sin 2\varphi}{\sin 2\theta_0} \sqrt{\frac{m}{\sin(\varphi - \theta_0) \sin(\varphi + \theta_0)}},$$

m — постоянная разделения, которая должна быть найдена из граничных условий.

Граничное условие для амплитуды E_1 на верхней поверхности кристалла $z=0$ имеет вид $E_1(x, 0) = E_0$ и является общим и для случая отражения и для случая прохождения. Используя его, находим

$$m = \frac{1}{4} \frac{(a_{11} \sin(\varphi - \theta_0) - a_{22} \sin(\varphi + \theta_0))^2}{\sin(\varphi - \theta_0) \sin(\varphi + \theta_0)},$$

откуда получаем решение уравнения (10), зависящее только от координаты z :

$$E_1(z) = c_1 e^{\kappa_1 z} + c_2 e^{\kappa_2 z}, \quad (12')$$

где

$$\kappa_{1,2} = -\frac{1}{2} - \frac{a_{11}\gamma_H + a_{22}\gamma_0}{\gamma_H\gamma_0} \pm \frac{1}{2\gamma_H\gamma_0} \sqrt{(a_{11}\gamma_H - a_{22}\gamma_0)^2 + 4\gamma_0\gamma_H a_{12}a_{21}},$$

$$\gamma_H = \sin(\varphi - \theta_0), \quad \gamma_0 = \sin(\varphi + \theta_0).$$

Подставляя (12'), например в (9'), находим решение для амплитуды E_2 :

$$E_2(z) = -\frac{\gamma_0 H_1 + a_{11}}{a_{12}} c_1 e^{\kappa_1 z} - \frac{\gamma_0 \kappa_2 + a_{11}}{a_{12}} c_2 e^{\kappa_2 z}. \quad (12'')$$

Постоянные c_1 и c_2 в (12') и (12'') определяются из граничных условий.

Дифракционное отражение

Если падающий и дифракционный лучи лежат по одну сторону пластины, то полная система граничных условий имеет вид

$$E_1(0) = E_0, \quad \gamma_H \frac{\partial E_2}{\partial z} + a_{22} E_2 |_{z=0} = -a_{21} E_0,$$

$$E_2(z_0) = 0, \quad \gamma_0 \frac{\partial E_1}{\partial z} + a_{11} E_1 |_{z=z_0} = 0.$$

Находя с помощью этих условий c_1 и c_2 в (12') и (12''), получаем окончательные выражения для амплитуд E_1 и E_2

$$E_1(z) = E_0 \frac{\eta \operatorname{sh} \frac{\xi}{2\gamma_H} (z - z_0) + \xi \operatorname{ch} \frac{\xi}{2\gamma_H} (z - z_0)}{\eta \operatorname{sh} \frac{\xi}{2\gamma_H} z_0 + \xi \operatorname{ch} \frac{\xi}{2\gamma_H} z_0} e^{-\left(\frac{\eta}{2\gamma_H} + \frac{a_{22}}{\gamma_H}\right)z},$$

$$E_2(z) = E_0 \frac{2a_{21} \operatorname{sh} \frac{\xi}{2\gamma_H} (z_0 - z)}{\eta \operatorname{sh} \frac{\xi}{2\gamma_H} z_0 + \xi \operatorname{ch} \frac{\xi}{2\gamma_H} z_0} e^{-\left(\frac{\eta}{2\gamma_H} + \frac{a_{22}}{\gamma_H}\right)z}, \quad (13)$$

где

$$\eta = a_{11} \frac{\gamma_H}{\gamma_0} - a_{22}, \quad \xi = \sqrt{\eta^2 + 4 \frac{\gamma_H}{\gamma_0} a_{12} a_{21}}.$$

Выражения (13) совместно с (8) полностью определяют направления распространения и величины волновых полей в каждой точке кристалла.

Для полубесконечного кристалла из (13) получаем

$$E_2(z) = E_0 \frac{2a_{21} e^{-\frac{\xi}{2\gamma_H} z}}{\eta + \xi} e^{-\left(\frac{\eta}{2\gamma_H} + \frac{a_{22}}{\gamma_H}\right)z}.$$

Отсюда находим коэффициент отражения:

$$R = \left| \frac{2a_{21}}{\eta + \sqrt{\eta^2 - 4 \left| \frac{\gamma_H}{\gamma_0} \right| a_{12} a_{21}}} \right|^2, \quad (14)$$

где в случае отражения $\gamma_H/\gamma_0 < 0$. Если коэффициенты a_{12} , a_{21} — чисто мнимые величины, то, как видно из (14), в области $\eta^2 < 4 \left| \frac{\gamma_H}{\gamma_0} \right| a_{12} a_{21}$ имеет место полное отражение энергии: $R=1$. Середина области полного отражения расположена при $\eta=0$. Используя это условие, с помощью (13) и (8) находим, что середина области полного отражения отличается от неисправленного угла Брэгга на величину

$$|\Delta\theta_0 = -\frac{a_{11}}{2\sin 2\theta_0} (1 + |\gamma_H/\gamma_0|).$$

Дифракционное прохождение

Выпишем полную систему граничных условий для этого случая:

$$\begin{aligned} E_1(0) &= E_0, \quad \gamma_0 \left. \frac{\partial E_1}{\partial z} \right|_{z=0} = -a_{11} E_0, \\ E_2(0) &= 0, \quad \gamma_H \left. \frac{\partial E_2}{\partial z} \right|_{z=0} = -a_{21} E_0. \end{aligned}$$

Используя эти граничные условия, из (12) находим

$$E_1(z) = E_0 \left(\operatorname{ch} \frac{\xi}{2\gamma_H} z - \frac{\eta}{\xi} \operatorname{sh} \frac{\xi}{2\gamma_H} z \right) e^{\left(\frac{\eta}{2\gamma_H} - \frac{a_{22}}{\gamma_H}\right)z}, \quad (15')$$

$$E_2(z) = E_0 \frac{\gamma_0}{\gamma_H} \frac{\eta^2 - \xi^2}{2a_{12}\xi} \operatorname{sh} \frac{\xi}{2\gamma_H} z e^{\left(\frac{\eta}{2\gamma_H} - \frac{a_{22}}{\gamma_H}\right)z}. \quad (15'')$$

Выражения (15) и (8) также позволяют определить направление распространения и величину волновых полей в каждой точке кристалла.

Так как в задаче дифракционного прохождения величина $\gamma_H/\gamma_0 > 0$, то анализ выражения (15'') показывает, что коэффициент пропускания

$$T(z) = \frac{2|a_{21}|^2}{\eta^2 + 4 \left| \frac{\gamma_H}{\gamma_0} \right| a_{12} a_{21}} \left(1 - \cos \frac{\xi}{\gamma_H} z \right) \quad (16)$$

испытывает колебания, амплитуда которых, однако, не уменьшается с глубиной, если только $\text{Re}a_{ij}=0$. При этом наибольшее значение $T = \frac{1}{2} (\gamma_0/\gamma_H)$ достигается при $\eta=0$. Из этого условия, а также из (15) и (8) находим, что максимум пропускания смещен на величину $\Delta\theta_0 = (a_{11}/2 \sin 2\theta_0) \times (1 - \gamma_H/\gamma_0)$ от неисправленного угла Брэгга. В частности, если отражающие плоскости перпендикулярны к поверхности кристалла ($\varphi = \pi/2$), то $|\gamma_H/\gamma_0| = 1$. Откуда следует, что отраженный луч распространяется точно в направлении, определяемом уравнением Вульфа—Брэгга.

В силу закона сохранения энергии интенсивность проходящего луча дополняется к интенсивности отраженного, определяемой выражением (16).

Проведенный анализ показывает, что решение задач о дифракции плоских волн на кристаллических пластинах, основанное на моделях нелокального взаимодействия, полностью совпадает с известными результатами работ [4—7].

В заключение отметим некоторые особенности при дифракции мёссбауэровского γ -излучения на ядрах с низколежащими резонансами [10—11].

Ядерный рассеивающий фактор в отсутствие сверхтонкого взаимодействия не зависит от угла дифракции. Поэтому при ядерном резонансном рассеянии ширина области полного отражения (в симметричном случае) зависит от угла дифракции как $\sin^{-1} 2\theta_0$ и не является монотонной функцией порядка отражения. При $\theta_0 = 45^\circ$ ширина области полного отражения минимальна, при больших углах она снова увеличивается. То же самое и в задаче дифракционного прохождения. Нижний предел области полного отражения совпадает с неисправленным углом Брэгга θ_0 (для перпендикулярной поляризации).

Другая особенность состоит в том, что ядерный рассеивающий фактор f_r по величине существенно больше атомного фактора f_a . Например, при рассеянии на ядрах Fe^{57} и на атоме железа отношение $f_r/f_a(0) \approx 50$ [10].

Отсюда угловые ширины дифракционных лучей (а также поправка к углу Брэгга) очень велики и значительно превышают соответствующие величины при дифракции рентгеновских лучей на атомах.

Автор благодарит проф. В. И. Иверонову за полезное обсуждение работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Колпаков А. В. «Вестн. Моск. ун-та», физ., астроном., № 1, 1970.
2. Гинзбург В. Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. М., «Наука», 1967.
3. Бломберген Н. Нелинейная оптика. М., «Мир», 1966.
4. Darwin C. G. Phil. Mag., 27, 315, 675, 1914.
5. Ewald P. P. Ann. d. Phys., 49, 117, 1916.
6. Ewald P. P. Ann. d. Phys., 54, 519, 1917.
7. Laue M. Ann. d. Phys., 23, 705, 1935.
8. Takagi S. Acta Cryst., 15, 1311, 1962.
9. Хирш П., Хови А и др. Электронная микроскопия тонких кристаллов. М., «Мир», 1968.
10. Кузьмин Р. Н., Колпаков А. В. Сб. «Аппаратура и методы рентгеновского анализа», вып. 1. Л., 1967.
11. Trammel G. Phys. Rev., 126, Nr. 2, 1065, 1962.

Поступила в редакцию
19.11 1969 г.

Кафедра
физики твердого тела